	רפת ת. ל357וג, ססג בו						
Перв. примен. СВЦЛ:4.35714,004	Полупроводниковый прибор КЕ7015БСЗА представляет собой биполярный силовой транзистор с изолированным затвором (БТИЗ) с технологией "Field—stop". Защитный диод в обратном включении Ключевые характеристики: 1. Рабочее напряжение: 1200В, ток: 15А 2. U _{кэ(нас)} =1,8В, U _{зэ} =15В, I _к =15А						
Cnpaß. N°	3. Низкие потери при переключении 4. U _{КЭ(нас)} с положительным температурным коэффициентом 5. Соотвествие стандарту RoHS Применение: 1. Преобразователи частоты 2. Источники бесперебойного питания 3. Системы кондиционирования 4. Приводы электродвигателей						
				На	значение выв	අංචියේ	
	Номер Функциональное Буквенное						
		<u>вывода</u> 1	назначе Затво		3	HUE	
даша		2	Коллекг	nop	K		
Noðn. u ðar		3	Эмит	птер 3			
	3		Ραδι	очие пара	эметры и кор	onyc	
-	Модель KE701						
one.		U _K	3		1200B		
Инв. № дубл.	T0-247-3L	I _K			15A		
-		U _{K3 Hac} , npL	ı T _{vj} =25°C		1.8B		
일		Тијп	nax	175°C			
Взам. инв. №		Маркир	оовка	KE70156C3A			
	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Корг	nyc	T0247-3L			
Подп. и дата	СВЦ/1.435714.004 Д1						
Jodn.					Масштаб		
		полупроводниковый КЕ7015БСЗА				_	
одv.	Пров. Шмаков Сп	полупроводниковый КЕ7015БСЗА О Лист			1 /lucmot	<u></u> გ 4	
Инв. № подл.	АО "Силової ключ"						
ZHG.	Н.контр. Тихомирова Утв. Цветков				ОИР		
	Копиров	<u></u> ФЛ		Ф	ормат А4	4	

ול לססי דו לכפול על האלי

Наименование

параметра

Напряжение пробоя

коллектор-эмиттер

№ докцм.

Подп

Дата

Взам. инв. №

Основные электрические параметры при температуре 25 (±5) °С

MUH

1200

Буквенное

обозначение

 $U_{K3\ npoK}^1$

Режим

измерения

 $U_{33} = 0B$, $I_{K} = 500 \text{MKA}$

Значение

mun

MOKC

Единица

измерения

В

	Ток утечки коллектор—эмиттер	U _{K3} =1200B, U ₃₃ =0B	l _{K3.ym}	1	_	1	мА
	Ток утечки затвора при прямом включении	U ₃₃ =20B, U _{K3} =0B	l _{3.ym} (np)	-	_	400	нА
	Ток утечки затвора при обратном включении	U ₃₃ =-20B, U _{K3} =0B	_{3.ym} (οδ)	-400	_	-	нА
	Пороговое напряжение затвора	$U_{33}=U_{K3}, I_{K}=1mA$	U _{33 nop}	3,5	4,5	5,5	В
	Напряжение насыщения коллектор—эмиттер	U ₃₃ =15B, I _K =15A,	U _{КЭ нас}	ı	1,8	2,1	В
	Заряд затвора		Q_3	ı	69	-	нКл
	Заряд затвор–эмиттер	U _n =960B, U ₃₃ =15B, I _K =15A	Q_{33}	-	7,6	-	нКл
4	Заряд затвор–коллектор		Q_{3K}	-	48	_	нКл
	Время задержки при включении		†зд.вкл	_	21	_	НС
	Время нарастания тока коллектоа		t _{нр}	ı	30	-	НС
\downarrow	Время задержки выключения	U _n =600B, U ₃₃ =±15B,	† _{зд.выкл}	ı	279	-	НС
	Время спада тока коллектора	I _K =15A, R ₃ =390м, Индуктивная	† _{cn}	-	238	-	НС
\downarrow	Потери энергии на включение	нагрузка, Т _{окр.ср.} =25°С	Евкл	ı	0,73	-	мДж
	Потери энергии на выключение		Евыкл	-	1,16	-	мДж
_	Общие потери на		E _{nep}	ı	1,89	-	мДж
	Входная емкость		C _{ies}	_	880	_	пФ
	Выходная емкость	U _{K3} =25B, U ₃₃ =0B, f=1МГц	C _{oes}	-	90	_	пФ
	Обратная передаточная емкость	. ""4	C _{res}	_	48	_	пФ
L							

Копировал

СВЦ/1.435714.004 Д1

*A*4

/lucm

|CBIL/1.435714.004 | II

Характеристики диода при температуре 25 (±5) °C

Наименование	Режим измерения	Буквенное обозначение	Значение			Единица
параметра			MUH	mun	MOKC	измерения
Напряжение на диоде в прямом включении	I _{np} =15A	U _{np}	I	2,6	3,2	В
Время обратного восстановление диода	U _{K3} =600B, I _{np} =15A, dI _{np} /dt=450A/MKC	† _{вос.обр}	-	131,5	-	HC
Пиковый ток обратного восстановления диода		l _{oδp max}	_	7,2	_	А
Заряд обратного восстановления		$Q_{\mathfrak{boc}}$	-	466	_	нКл

Предельно допустимые значения электрических параметров

обозначение	норма при эксплуатации	Единица измерения	Примечание
U _{K3 max}	1200	В	_
U _{33 max}	±20	В	_
I	30	А	Т _{окр.ср.} =25°С
'K max	15	А	Т _{окр.ср} =100°С
I _{K,u max}	45	А	t _{umn} , f npu Τ _{vj} не δοлее Τ _{vj max}
I _{np}	15	А	Т _{окр.ср} =100°С
I _{np max}	45	А	t _{имп} , f при Т _{vj} не более Т _{vj max}
t _{кз}	10	MKC	-
D.	245	Bm	Т _{окр.ср} =25°С
' max	122	Bm	Т _{окр.ср} =100°С
$T_{pa\delta}$	–40 do 175	°(_
T_{xp}	-55 do 150	°[-
	U _{K3 max} U _{33 max} I _{K max} I _{K,u max} I _{np} I _{np max} † K3 P _{max}	U _{K3 max} 1200 U _{33 max} ±20 I _{K max} 30 I _{K,u max} 45 I _{np} 15 I _{np max} 45 t _{κ3} 10 P _{max} 245 T _{paδ} -40 do 175	$U_{K3 \text{ max}}$ 1200 B $U_{33 \text{ max}}$ ±20 B $I_{K \text{ max}}$ 30 A I_{5} A $I_{K,u \text{ max}}$ 45 A I_{np} 15 A $I_{np \text{ max}}$ 45 A $I_{mp \text{ max}}$ 45 A $I_{mp \text{ max}}$ 10 MKC $I_{mp \text{ max}}$ 245 Bm $I_{mp \text{ max}}$ 122 Bm $I_{mp \text{ max}}$ -40 do 175 °C

Ī	Изм.	/lucm	№ докцм.	Подп.	Дата

СВЦ/1.435714.004 Д1

/Jucm

LB 400.4172554.14.004 [1]

Тепловые характеристики

Наименование параметра	Буквенное обозначение	Макс. значение	Единица измерения
Тепловое сопротивление кристалл—корпус (БТИЗ)	R _{OJC (VT)}	0,61	°C/Bm
Тепловое сопротивление кристалл—корпус (Диод)	R _{OJC (VD)}	0,77	°C/Bm
Тепловое сопротивление кристалл—окр. среда	R _{⊕JA}	40	°C/Bm

Указания по применению и эксплуатации кристаллов КЕ7015БСЗА приведены в ТУ, СВЦ/1.435714.004 ТУ

ВНИМАНИЕ – Соблюдайте меры предосторожности при работе – ПРИБОРЫ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ К СТАТИЧЕСКОМУ ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изм.	/lucm	№ докцм.	Подп.	Дата

СВЦ/1.435714.004 Д1

/lucm

Копировал

*A*4